

## ★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 平野博茂 副委員長 大見俊一郎

幹事 森 貴洋・小林伸彰 幹事補佐 野田泰史・諏訪智之

日時 10月22日(木) 10:00~16:20

会場 オンライン開催

議題 プロセス科学と新プロセス技術

1. 〔記念講演〕 プラズマを利用した原子層制御エッチングプロセス 熊倉 翔 (東京エレクトロン宮城)
2. 3次元積層に向けた高容量密度・高耐圧 SiN 絶縁膜粗面トレンチキャパシタの開発 ○齊藤宏河・吉田彩乃・黒田理人 (東北大)・柴田 寛・柴口 拓・栗山尚也 (ラピスセミコンダクタ宮城)・須川成利 (東北大)

午後

3. The influence of RF sputtering condition for LaBxNy dielectric layer formation for floating-gate memory applications  
○Kyung Eun Park・Hideki Kamata・Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Tech)
4. A two-step wet etching process for the integration of PdEr/HfO2 gate stack structure on the gate-first Schottky barrier MOSFET ○Rengie Mark D. Mailig・Yuichiro Aruga・Shun-ichiro Ohmi (Tokyo Tech)
5. Investigate the characteristic of rapid solid phase crystallization of amorphous silicon films induced by micro thermal plasma jet ○Hoa Thi Khanh Nguyen・Hiroaki Hanafusa・Yuri Mizukawa (Hiroshima Univ.)・Shohei Hayashi (Toray Res. Cent.)・Seiichiro Higashi (Hiroshima Univ.)
6. IPA を用いた銅・酸化銅上の表面改質 ○間脇武蔵 (東北大)・寺本章伸 (広島大)・石井勝利 (東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ)・志波良信・諏訪智之 (東北大)・東雲秀司・清水 亮・梅澤好太 (東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ)・黒田理人・白井泰雪・須川成利 (東北大)
7. 強誘電体薄膜 BiFeO<sub>3</sub> の格子整合と X 線構造分析 ○今泉文伸・仲田陸人 (小山高専)
8. 統計的計測によるドレイン-ソース間電圧がランダムテレグラフノイズに与える影響の解析  
○秋元 瞭・黒田理人 (東北大)・寺本章伸 (広島大)・間脇武蔵・市野真也・諏訪智之・須川成利 (東北大)

☆SDM 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

12月2日(水) 龍谷大響都ホール校友会館〔未定〕テーマ：シリコン関連材料の作製と評価及びディスプレイ技術

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<https://www.ieice.org/ken/program/index.php>

【問合先】

森 貴洋 (産総研)

TEL [029] 849-1149

E-mail: mori-takahiro@aist.go.jp